

電界効果トランジスタ

2SK301

**2SK301**

T-29-25

シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

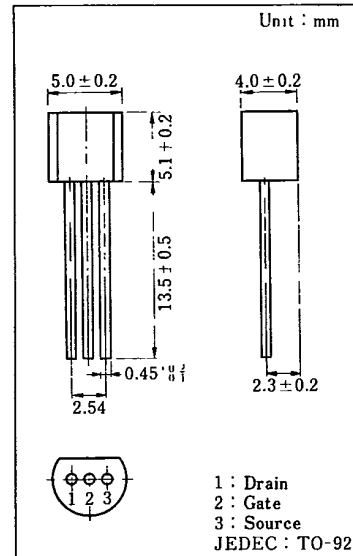
低周波増幅用, スイッチング用 / AF Amplifier, Switching

## ■ 特徴 / Features

- 低雑音, 高利得 / Low-noise, high gain
- ゲート・ドレイン電圧  $V_{GDO}$  が高い。 / High  $V_{GDO}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DSX}$	55	V
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDO}$	55	V
ゲート・ソース電圧	$-V_{GSO}$	55	V
ドレイン電流	$I_D$	30	mA
ゲート電流	$I_G$	10	mA
許容損失	$P_D$	250	mW
接合部温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim +125$	$^\circ\text{C}$

電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン電流	$I_{DSS}^*$	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0$	0.5		20	mA
ゲートシャ断電流	$-I_{GSS}$	$-V_{GS} = 30\text{ V}, V_{DS} = 0$			10	nA
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDS}$	$-I_G = 100\ \mu\text{A}, V_{DS} = 0$	55			V
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{DS} = 10\text{ V}, I_D = 10\ \mu\text{A}$			5	V
相互コンダクタンス	$g_m$	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{ kHz}$	2.5	7.5		mS
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{ MHz}$		6.5		pF
帰還容量	$C_{rss}$			1.9		pF
雑音指数	NF	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0, R_g = 100\text{ k}\Omega, f = 120\text{ Hz}$		0.5		dB

\*  $I_{DSS}$  ランク分類 /  $I_{DSS}$  Classifications

Class	P	Q	R	S
$I_{DSS}$ (mA)	1~3	2~6.5	5~12	10~20

電界効果トランジスタ

2SK301

T-29-25

